

低溫微波加熱系統標準製程

- Si : 400% 300 s for S/D activation
(P/As/BF₂ , 10~15keV , 1~2E15cm⁻²)
- Ge : 275% 100 s for S/D activation
(P/As/BF₂ , 10~15keV , 1E15cm⁻²)